PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-354800

(43) Date of publication of application: 24.12.1999

(51)Int.Cl.

H01L 29/786 H01L 21/336

(21)Application number: 10-

(71)Applicant: HITACHI LTD

155586

(22) Date of filing:

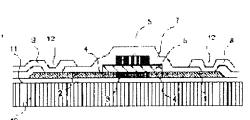
04.06.1998 (72) Inventor: SATO TAKESHI

KAWACHI GENSHIRO

(54) THIN-FILM TRANSISTOR, ITS FORMING METHOD, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reliable thin-film transistor due to a high On current with a low-resistance LDD region. SOLUTION: A thin-film transistor consists of a gate 5, a gate insulation layer 6, a channel 3, a source 1, a drain 2, and an LDD region 4. At this time, the channel 3 is formed by a polycrystalline Si film with an average particle diameter of 1/10 or less of the channel length. Also, the LDD region consists of an Si film where a crystal grain boundary does not cross a current path from the channel 3 and that is regarded nearly as a single crystal in a current flowing direction.



IFGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本PBB南岸(19) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開基号

特開平11-354800

(43) 公開日 平成11年(1999)12月24日

	į.				
- 1:51	- }	bot	(

鐵明記号

FI

H6 1 L 29/786 21/3.85

HOIL 29/78

616A

618D

6276

審査請求 未請录 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)相顯番号

特顯平10-155586

(71)出職人 000005168

株式会社自立製作所

(22)出願目

平成10年(1998) 6月4日

東京都千代田区韓田駿河台四丁目6番池

(72)発明者 佐藤 建史

歌城県日立市大為か町七丁目1番1号 挟

式会社自立製作所自立研究所内

(72) 発明者 河内 玄土朝

茨城県日立市大岛が町七丁目1番1号 株

式会社自立製作所自立研究所内

(74)代理人 奔建上 小川 勝男

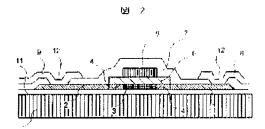
(54) 【発明の名称】 |燐騰トランジスタ及びその形成方法並びに被局表示装度

J. 15 (1945)

(直正有)

【課題】既把成立、自自簿域を育し、高いすご電流によ る高信制質の薄輳しランジスタを提供する。

【解決も提】と「15」で一手絶縁層り、チャカル3。 ニーフレートレス しょりりり領域4からなる薄膜トラ しょうなんち マーチャネルは、チャネル裏のモビ1百 PTFの4つ投資を育する多結膜Si鰻で形成され LD 1 歯域は、結晶経界がチャネルからの審議経路を横切ら コー目の基施が同時に概む単結晶よみなせるS・暖からな λ,...



【持許請求計論印】

(調大師) アートし

前記アートトルグルト連線層を介して形成され、且つ .治療時の見折1111的域される事導体験からなるチャネル

前記されていから今離された素濃鉢變からなり、ドイブ

前記とディルを配合シンス制造がに、前記サイスルと前 記下にく、間に強制マース点は、前記とレインより低濃 度にトーニスれた主導体機がれなる計画を領域とからな。10~を持たせ、低強機鎖域から高磁度鎖域に向かってほぼ争 る薄輳↓ ○ こうさずあって。

前記されて小さ、ファイル長の!。上り以下の平均技隆 を書する多点結合・膜で化めるれ、前記しり負領域は、 結晶結解が前訳させずいからの電濾経路を満切らず、且 一環流的向に動力學結構と方なせる3)膜がらなる薄膜 F. 20 1 3.

【護す項は】誰す項上にわらず、

前続き、主演舞器を介える御記とときに選われた多緒島 アト騒がわかかささずれた

前記されている前記で、区間並びは、前記チャイルを前、20 **歌ラレイ 関方前記り 下途縁膜に覆われ 昼つ前記が** 中に復われていかい結晶性の主膜がらなるし00鎖糖 もと音は必薄膜 ベージ・アス

【語の項3】語り項目において

トーマード連体膜に前語ゲート絶縁膜をマスタとし カイオート・フルカ前記 1~ くなび前記ドレインとなる puter 3 1.

前額サットがクラグとしたわっせてこうがわ。ディネル 力性の非遺れ嫌の溶融して フェス 砂砂トレイン むチャネ 5.とう境壁の・「上終縁層に覆われた丰濃体膜をトーフ」3) を形成する方法がある。 1 こしに 翻訳さりる薄膜を与しいでは形成方法。

(誰中頃4) ファリセス投げ形成された画素をスイッチ は 赤縄 初度1まんはじの 簡購上ランプスタモ、

前認薄膜トラー、こうを駐動する駆動回路の一部または 全部は間、基拠上に形成された薄膜トランジスタ基板

前副薄胴1・・・ニス基拠と対抗する対抗基板の間に液 点を連結した設品層とか育する液晶表示装置。

(克) 即位計劃立[6]明]

(1001)

[空時の信さら時間分野] 本発明は液晶萎示装置。特に 部動師能が自縁にん液晶声主接層に用いられる薄膜トラ 1000年11日本。

\$ 1000 C.

(在中の役割)公園を主鉄置は高画層北、低価裕化か求 さいわしいん 薄膜上土 ジスタにより駆動回路を形成 これは基拠し日常しの接続点数を増加させることなく配 「複数な糟加えき」 国精細化が可能となる。また「駆動回」 ¥87/31に抗な存成でき、明ラスト比が図れる。駆動回路 - 江南労力派に「十二萬橋が昭られる護職トランジスタを形」59 - DD領域から注入されるホット ドドリアが水幅に接続す

「戒するには、高い結晶性を持ったミエ顆を用いる毛要か」 ある。しかり、液晶素玉装置に用いる耐熱性の低いカラ ス基板上には単結晶のSi襞を均一に彫成するでとは鉋 誰であるため、レーサによりアモルファスの(鰻肉アン - 中して結晶化した結晶性の名も多結晶の 4 膜を用いた 薄膿トランシスタが美に明いられている。しょせを聞い たアニートではレーサ光の強度により得われるそ結晶と →驥の粒径を制御できることが知られている。また。↓ りら、膜の結晶性を改善するにはレーサガの強度に今布 結晶とみなせるS)膜の海域を依要させる方法が知られ こしょう。

【自身自身】また、ヒースの自身しょうさきょう外の様 舞び、フィス及び下していより低速度がトップされた。 DD 領域を設け、チャネルもトレインの境界の奮門をし DD資域に分担して駆動回路に必要な耐圧を得ることか 行われている。従来側の薄膜トランジスタの上面凹を図 らに、鮮面図を図すに示す。チャネル含むカート語縁膜 も及かセートをによりマスクして低と一つ置てイナン マワーによりトーコも、さらに負む負債はなるボトリン により形成したもって下をマスケしたでリードと発力す トイン2に高トース置てメサンシャワーです。 - ジストを除去してアニールによりオープした♪。 を活性化して 1ー315トレイン ごびひしじ ご隠域する 形成する。CVDによりますの、からなる層間絶縁膜で を要板の耐熱温度500℃以下で堆積し、層間絶縁膜で にボトログを用いこり、トホール!じる閘門もた後金属膜 を増積し、ボトリリにより 1、ス英極とと下、イト高松 9に誕生して、四きのひ回4の構造の薄膜トランにこの

{00004}

【発明が解決しようとする課題】従来の薄膜トラートで なではLSD海域は多結晶S・膜により形成されてあ り、抵抗が高くチャネルカー。下及びラレインが関係抵 抗か大きいため、オン電流が少ない問題がある。アニー |八時のレー母光の強度を上げて多結晶ミト膜の症候を特 大きせるともDD領域の抵抗は低減されるか、ドイイル 内の結晶粒の数が減少し、薄膜トランジスタの特性のは らつきが大きくなる問題がある。また。レード海筋守育 45 により形成された概ね単結晶顕微を用いる方法では一層 膜トランシスタを形成するのに必要な大きな領域を得る のが困難であるという問題がある。

【うりり5】本発明の目的は、職圧、物・能をお化させ ることなり、低低抗なしDD鎖域を買り高いすご常権が 得られる薄膜トラントスタを提供するだってはる。

【0006】また図4の荷楽の薄膜とうしらりゃくは、 上DD鎖域はほらVDでもロモ与けての低温で強持され たらもの。からなる層間絶縁膜でにより緩われている。 わかり、低温形成された字子の、膜には実幅が多く。に

六、層間が減費に蓄積された電荷がしむり鎖域4を望乏 1) 「高振抗化」 すご電流を低下させる問題かあっ

【ロ・ロ・7】 大文明の夢との目的は、LDD鎖域を窺う - 治療暖の腕質が自好な薄膜トランシスタを飛賊が一しひ 遠域の批抗増加を抑制してする蓄流の減少もない高信 **福性の護服士・1000 できる提供することにある。**

[2003]

【津順を転決するための手段】零発期は、上記目的の1 ▼1、ボンバートト方にゲート終縁層を介して形成さし 17、日本経済は7世極上に利益される半導体膜からなる と; 14年、「面部リテネルから号離された半導体機から 分り、上、さきれた。いってかび下立インと、前記チャネ まる前部1000 1間部が4000 前部チャネルと前記されるこ 闘な配記と、1500、前記トレイにより低濃度に下って された手濃計嫌からなるしむじ鎖域とからなる薄膜トラ こうとうでもして、前記させる小は、チャネル長の上ア [10]、下心中的な存を有する多結晶の主膜で形成され、 言語を描切れず、自つ高速方向に概ね単結晶をみなせる 三十蠖がれなら薄膜上ランンごうである。

1 「10115~77」・4方。1.00多域が、電流が癒れ え方向に結晶が見かない構成から、薄膜トランジスタの 新村のit いっきり神え、1.00の領域の遷杭を低く出来 1.

[market]

(発明のき励いと無力リト | 本発明の実施方法を説明す

アマロ・上記す 1月ごはそで動画図を示す。

【1011~】 さぬ聞る)贈りらなるさデネルのとっきゃ マルン振れる電流の向きといに成長した結晶校立しから たるとも担心性のされたしむり鎖域4を有する薄膜上ラ 、アダウもそ、チャネル3の多結晶3)腹は、平均稜 買がチャイ (おか) ロテカト状上では薄膜トランジスタ の特性の いっぱきかたさくなるため、平均の結晶粒径が チェルに300m 3001の号の11世界 - 望雲もくは20分 に、南漢で作れる方向には結晶投界がなり、概和単結晶 こんなせるの、嫌も形成されている。このためもDD鎖 何の承抗は結晶性がよいたがほぼ単結晶の場合と同じ程 度もて周される。主に電流が改善されている。

[ロートル]を13、お発肺が薄膜トランジスタでは、1 中中海峡 10: 10 10 からなるが一下絶縁膜もに覆わっ (4) トードはおんど、腰からなるか、下方に緩われてい。 かい海峡におれてれたいる。たい土絶縁膜らば層間絶縁 肥了 100 景(したが、 コイ・コットをあまり低下させるじ 人は、明清中的トラけんによかでき、層間絶縁襞でより、55、制されて高い信頼性が得られる。

低欠陥に形成できる。とDD鎖域4か層間絶縁嫌で心臓 われる従来構造に対か、ケート過縁競りに覆われた下発 明の講造では絶縁膜中の欠陥によるホートキャリアの蓄 積か低減されるためしDD海域はの空乏性が従来講讲に 比べ緩和され 信頼性が向上する。

【0014】図6と図6は本発明による薄膜】 ・・・ご 々の形成法の倒てある。

【)4)5 】図ちょとに多結晶3)襞の形成法を示す。 カラスからなる透明経縁基拠しり上に合いり、からなる つきまた。とも解析するものであり、その特徴は、ケー、16、保護験11を介して、コチリファブの(願ここを广ソウ 法により推論する。ベルスエキーマレーサを母いし、ザ 光4つを走査して結晶化な、多結晶の主膜でのよする。 ことで、一分強度は得られる多層晶は主題の平均で落晶 粒径がチャネル長の10分の1別下点なるように調整さ れる。次にボトリンをあたいて多結晶ミュを島径が加工 1. その上に含すり、薬がサントップされたアモルファ スタイ膜をGVPにより維護する。ホトリッを用いてミ 10、からなるケート絶縁瞬じまれンドーフされたアモ ルファスミ・鰻からなるゲートを含それぞれ形成して図 前続した。如果(1) 結晶被導が蘇記チャネルからの意義(20)5分)のゴケーンを形成する。 光に図るさらに下すまち にゲート経縁機らをマスさとしてイオンシャワーは1に より、ソースミラのトレイン会にサンをトーフにする。 その後、再びレーザドニールを行う。四69)におい で、ゲート方をマスクと打てレーサ光4日を注査し、。 ース1、トレイン2度3度研鎖域4を溶離する。。 C 1及びトレインとよりLDD顕繊はいちーゴシャである。 可しが拡散し、トープされる、きた、溶融したしもう道 繊維は密融していないチェダリカから熱を奪われるだ。 め、チャネル側から凝固してターご1至ひ下に / 1 ごん 36、向けて結晶成長し、フェストとトレインでの間のキャイ の3を介して流れる電流方向に微和単結晶とみなせる鎖 域からなる1.DD鎖域すり形成される。なお、ユニアル 一直促生的,建立本一团医新店 不毛排刀一只只有个的证 るテート与も結晶化され、低抵抗の電硬になる。さらに 図もりに示す様に、ナート絶縁膜らをマスカとしたイ オンシャウェル(により、バース)助かしい子に変を高 議僚に共に十一プレも後、400円の原製処理により十一 パントを活性化しょっさり、トレインと参びし自動通知 する形成する。最後に図るとしに示すように含まり合い。 ロロとからようがフェールされる。また、LDD超域は、40~名なる層間遊練嫌?をCVDにより遊禱ルーチトリアに よりつンタクトホール18を閉回れたは、金属競毛堆積 して裏ひボトリンにより電子してコース電極とサルトン イン電極の変形成し、薄膜トラントスタを得る。

【うり16】本形成法によれば、「、DP領域(多量なべ 一ト絶縁膜もは関わるとが示すようがしゃサアニーに時 に溶融した1.00類域はにより切納されてもいいません の高温でアニールされ、アート絶縁襞ら中の大幅が低減 される。これによりケート始縁膜もへのボットキャリア の蓄積が防止され、1,00億減の空ごれ、高級政化が押。

(ロロリフ)())では水発明による液晶表示接置の薄膜上 テー、アス基拠が何である。薄膜トランシスタ墓板30 上に適明高極からなる画素整整34かマトリカス状に形 戒され、歯犬は成り5カ形成されている。画業奪極34 エトレイー認っじかれの信号幕圧をダート線31の幕圧 ぶもり 1 ・ 1 1183~・ 1 こなる薄膜トランシスタ3 30年前におている。また、ゲート課金(を駆動するか --ト駆動回端さり、行けらしてい線38を駆動するトレ イン駆動回給して水道膜トランドで多量板の画素領域3 れている。本意明の主に露流が敬誉された薄膜トランジ こうを知いることにより、 ドット複31及ひ上レイン復 当じも駆動するのに上分な高い駆動力が得られ、駆動回 「路の適勝」 アーンドの基物上に形成できる。これによ り、画学し、さた高精細化でき、また製造コストが低減 できる。ぎん。本発明の薄蠖トランジスタは、画素スイ → 47 (夢)がるれる#j--な特性は耐圧に優れ低いオブ電衝 か得られらんが、 画家建築さすをフィーサする薄糠トラ ここでダッコに対いるただもできる。これにより画素質 域からと約3000円、上級約節踏からびかましてい難動回、25、上1一保護膜、上2、コンタクトホール、2)、落復所 霜もでの薄腹・・・ニタケ同一プロセスで形成でき、 工資料を仰えるたとかできより低コスト化が図れる。 [0.01%]

【発明の時見】下発明によれば、均一に高いすい電流を 真する論時、情報性にすぐおた薄膜トランシスタが得ら れ、高両智・光)「上が遊晶多元装置が得られる。」

*【図面の朝草な説明】

【図1】本発明の薄膜トナンシスタの一系統例の上面図 を示す図である。

【図2】本発明の薄膜トランシックの一菩婉例の歌面匠 を示す図である。

【図3】従来の薄膜トラップコロー実施例の上面図を 示す図である。

【図4】従業の薄膜トランプニタの一事施師に断面図を 示す堕である。

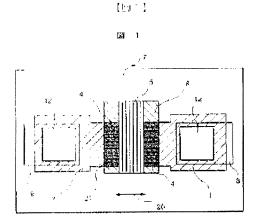
5 / 周辺に、土の則の薄蠖トランにスタを用いて形成さ、10 【圏も】本発明の薄膜トゥード こうの 一形成ち囲を至す 図である。

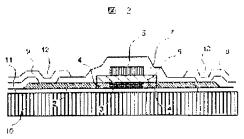
> 【図る】家発明の薄膜トラントではの他の形成方法が下 す図である。

> 【図7】本発明による液晶素土装置の薄膜トランドです 基板の一葉施剛を示す図である。

【符号の説明】

鎖域 5~ケート 6~* 上海緑鱒 7・膣間絶縁 腹、8~、一ク電極、5~トレイン電極、10~夏姫、 向 2.1 結晶粒 2.2、アモルファクラ・腹 2.3 多結晶S:膜:3)・薄膿トランミスタ基板、3))が →下線、32冊トルイン線、33・薄膜上ラーン33. 34・画素電極 35・画素組織、36・5 ト級動団 路 37 十レイン能動回路 すい モーガギ ユー・ イオンシャサール





(mag]

